valid OMB control number.		Application Number	10/020,561
TRANSMIT	TRANSMITTAL		December 7, 2001
FORM (to be used for all correspondence after initial filing)		First Named Inventor	Joachim Schroeder
		Group Art Unit	Unk.
		Examiner Name	Unknown
Total Number of Pages in This Subr	nission	Attorney Docket Numbe	LO25-009
	ENCLO	SURES (check all that app	oly)
Fee Transmittal Form	ransmittal Form Assignment Papers (for an Application) Fee Attached Drawing(s)		After Allowance Communication to Group
Fee Attached			Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences.
Amendment / Response	Licensing-related Papers		Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief)
After Final	Petition Routing Slip (PTO/SB/69) and Accompanying Petition		Proprietary Information
Affidavits/declaration(s)		to Convert to a onal Application	Status Letter
Extension of Time Request	Power of Change Address	of Attorney, Revocation of Correspondence	Additional Enclosure(s) (please identify below):
Express Abandonment Request		al Disclaimer	PTO Return Postcard Receipt.
Information Disclosure Statemen	1 1 1	Entity Statement	Тесстри
Certified Copy of Priority		st for Refund	
Document(s) Response to Missing Parts/	Remarks	-	NO FEE IS DUE. The harge any deficiency or credit any
Incomplete Application		to Deposit No. 23-0925.	marge any deficiency of credit any
Response to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53			,
SIGNATU	JRE OF APPLI	CANT, ATTORNEY, OR	AGENT
Firm or			
Individual name D. Brent Kenad	ly Reg. No. 4	10,045; Wells St. Joh	n P.S.
Signature Sulve	<u>~~</u>		
Date 3-13-02			
	OFPTIFIO	ATE OF MAILING	

Burden Hour Statement This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount efficier Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Application Serial No
Filing Date December 7, 2001
Inventor Joachim Schroeder et al.
Assignee Carl-Zeiss-Stiftung
Group Art Unit Unassigned
Examiner Unassigned
Attorney's Docket No LO25-009
Title: System For Flushing At Least One Internal Space of an Objective

System For Flushing At Least One Internal Space of an Objecti

CLAIM FOR PRIORITY

To:

Assistant Commissioner for Patents

Washington, D.C. 20231

From:

D. Brent Kenady

(Tel. 509-624-4276; Fax 509-838-3424)

Wells, St. John P.S.

601 W. First Avenue, Suite 1300

Spokane, WA 99201-3828

Customer No. 021567

Sir:

In accordance with the provisions of 35 U.S.C. §119, applicant hereby claims the benefit of the filing date of applicant's corresponding German Patent Application Number 101 45 075.3, filed on 13 September, 2001 (13.09.01), and German Patent Application Number 100 61 480.9, filed on 8 December, 2000 (08.12.01), the certified copy of which was provided previously on February 25, 2002.

A certified copy of the originally filed German Patent Application (101 45 075.3) is enclosed.

Acknowledgment of receipt of this priority document is respectfully requested.

Respectfully submitted,

Dated: 3-/3-02

D. Brent Kenady Reg. No. 40,045

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND





Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

101 45 075.3

Anmeldetag:

13. September 2001

Anmelder/Inhaber:

Carl Zeiss, Heidenheim/DE

Bezeichnung:

System zum Spülen wenigstens eines Innenraumes

eines Objektives

Priorität:

8. Dezember 2000 DE 100 61 480.9

IPC:

G 03 F und G 02 B

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 27. Februar 2002

Deutsches Patent- und Mark namt

Der Präsident

Im Auftrag

Hiebinger

A 9161 03/00 FDV-I Beschreibung: ' 00106P

System zum Spülen wenigstens eines Innenraumes eines Objektives

5

Die Erfindung betrifft ein System zum Spülen wenigstens eines Innenraumes eines Objektives, insbesondere für die Halbleiter-Lithographie.

10 Es ist allgemein bekannt, Objektive, insbesondere Objektive für die Halbleiter-Lithographie, gegenüber der Umgebung abzudichten und zur Vermeidung einer Kontamination von außen her den bzw. die Innenräume des Objektives mit einem Spülgas zu spülen, wobei mit einem leichten Überdruck operiert wird.

5

Aufgrund der chemischen Beständigkeit von inerten Gasen ist bereits vorgeschlagen worden, eine Spülung mit einem derartigen Gas durchzuführen.

- Zum allgemeinen Stand der Technik hierzu wird auf die US-PS 5,157,555 verwiesen, in der vorgeschlagen worden ist, eine Korrektur von sphärischen Aberrationen durch einen variablen Luftspalt zwischen benachbarten Oberflächen vorzunehmen.
- In der US-PS 6,252,648 B1 ist eine Belichtungsvorrichtung in der Mikrolithographie und ein Belichtungsverfahren beschrieben, wobei ein abgeschlossener Raum in einem Objektiv zur Vermeidung von Kontamination und zur Reinigung eine Mischung aus einem inerten Gas und Sauerstoff eingebracht wird.

30

In der US-PS 4,871,237 ist vorgeschlagen worden, durch Ändern des barometrischen Druckes eines Innenraumes eines Objektives die optische Abbildegenauigkeit eines Objektives zu verbessern. Als Medium für den Innenraum werden verschiedene Gase und Gasmischungen vorgeschlagen um den refraktiven Index in der Gasmischung zu ändern.

Die Spülung mit einem inerten Gas verursacht vergleichsweise

hohe Kosten, welche zwar während des Betriebs eines Objektivs durchaus zu akzeptieren sind, in der Phase der Justage und des Montierens jedoch einen erheblichen Kostenaufwand verursachen. Möchte man nun ein Objektiv in dieser Phase der Montage und des Justierens mit dem sehr kostengünstigen Spülgas Luft betreiben, so berechnet sich dessen Abbildung für ein Spülen mit Luft. Soll das Objektiv in seinem endgültigen bestimmungsgemäßen Einsatz dann jedoch mit dem sehr viel teureren inerten Gas gespült werden, so ergibt sich das Problem, daß diese Gase einen Brechungsindex besitzen, der deutlich von dem Brechungsindex von Luft abweicht. Die Folge davon sind Bildfehler, die zu einer Fehlfunktion des Objektives führen würden.



Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein System zum Spülen wenigstens eines Innenraumes eines Objektives zu schaffen, wobei einerseits der Einsatz von inerten Gasen zum Spülen ermöglicht, andererseits kein veränderter Brechungsindex eingeführt wird.

20 Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die in Anspruch 1 genannten Merkmale gelöst.

Erfindungsgemäß werden nunmehr inerte Gase derart miteinander gemischt, daß der daraus resultierende Brechungsindex dem Brechungsindex von Luft entspricht. Auf diese Weise wird erreicht, daß die Objektive, beim Justieren und bei der Montage zuerst mit dem sehr günstigen Spülgas Luft betrieben werden können. Erst bei der Endjustage und/oder dem endgültigen bestimmungsgemäßen Einsatz der Objektive vor Ort wird dann auf eine Spülung mit einem inerten Gasgemisch umgestellt. Dies bietet dabei die Vorteile einer chemischen Beständigkeit über einem langen Betriebszeitraum. Durch die Anpassung des Brechungsindexes werden Bildfehler, die zu einer Fehlfunktion des Objektives führen, sicher vermieden.

35

In der Praxis hat sich durch Versuche herausgestellt, daß sich auf wirtschaftliche Weise die gestellte Aufgabe sehr gut lösen läßt, wenn bei Verwendung von zwei inerten Gasen als Gase

Stickstoff und Helium verwendet werden, wobei Stickstoff den Hauptbestandteil mit 95 bis 99,5 Volumenprozent darstellt, vorzugsweise sogar 98,8 % und mit dieser Mischung läßt sich ein Brechungsindex in Verbindung mit Helium schaffen, der dem von Luft weitgehend entspricht.

Selbstverständlich sind im Rahmen der Erfindung auch noch andere inerte Gasmischungen möglich mit anderen Gaszusammensetzungen.

10

Durch eine entsprechende Anpassung bzw. Mischungsverhältnis lassen sich im Bedarfsfall auch noch gezielt Brechungsindexänderungen zur Korrektur von auftretenden Bildfehlern einstellen.



Dies bedeutet, daß durch dieses Gasgemisch im Bedarfsfall nachträglich auch noch bereits in der Praxis eingesetzte Objektive verbessert werden können.

Nachfolgend ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand 20 der Zeichnung prinzipmäßig beschrieben.

Es zeigt:

Fig. 1 ein Projektionsobjektiv einer Projektionsbelichtungsanlage für die Halbleiter-Lithographie, und



25

30

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Projektionsbelichtungsanlage mit einem erfindungsgemäßen Projektionsobjektiv.

In der Figur 1 ist ein Projektionsobjektiv 1 für die Halbleiter-Lithographie nur teilweise und nur im Prinzip dargestellt, da dessen Aufbau grundsätzlich bekannt ist. Das Objektiv 1 weist eine Vielzahl von Linsen 2 auf, die über Rahmen bzw. Halterungen 3 mit dem Objektiv verbunden sind.

Das Innere des Objektives ist gegenüber der äußeren Umgebung abgeschlossen bzw. wenigstens weitgehend abgedichtet, wobei in

der Regel mehrere einzelne Innenräume 4 zwischen den Linsen 2 vorhanden sind. Die Innenräume 4 stehen unter einem leichten Überdruck und werden über sehr kleine Bohrungen 5 gespült, wobei Bohrungen 5a Einlaßöffnungen und Bohrungen 5b Auslaßöffnungen darstellen.

Ganz allgemein kann die Spülung auf folgende Weise durchgeführt werden:

- Die Spülung kann durch ein Gasgemisch, bestehend aus Stickstoff mit einem Volumenanteil von 98,8 % und Helium als Edelgas mit einem Volumenanteil von 1,2 % erfolgen. Gegebenenfalls ist anstelle von Helium auch die Verwendung eines anderen Edelgases möglich, wobei selbstverständlich in diesem Fall die Zusammensetzung dann entsprechend geändert werden muß, damit insgesamt ein Brechungsindex in den Innenräumen 4 entsteht, der dem von Luft entspricht, für welches das Objektiv 1 berechnet worden ist.
- Die Berechnung zur Angleichung des Brechungsindexes des Gasgemisches aus Stickstoff und Helium zur Anpassung an den Brechungsindex von Luft erfolgt entsprechend der nachfolgenden Formel:
- 25 $n_{mix} = n_1 * q_1 + n_2 * q_2$

- mit $q_1+q_2=1$. n_{mix} : Brechungsindex der Mischung; n_1,n_2 : Brechungsindex von Gas₁ bzw. Gas₂; q_1 , q_2 : Anteil von Gas₁ bzw. Gas₂.
 - Mit Luft ist eine Zusammensetzung von Stickstoff und Sauerstoff gemeint, die selbstverständlich im Rahmen der Erfindung innerhalb eines gewissen Bereiches schwanken kann. Dies bedeutet, mit dem in der Anmeldung verwendeten Ausdruck "Luft" sind ganz allgemein luftartige Zusammensetzungen gemeint. So kann z.B. als Luft synthetische Luft verwendet werden, wobei der Anteil von Stickstoff zwischen 78 und 80 Volumenprozent und der Anteil von Sauerstoff zwischen 20 und 22 Volumenprozent liegt.

Nachfolgend sind konkrete Ausführungsbeispiele für eine nur beispielsweise angegebene Wellenlänge angegeben. Die Brechzahl-Angaben beziehen sich jeweils auf eine Temperatur von 22 °C und einen Druck von 950 mbar. Brechzahlen, die sich auf andere Temperaturen und Drücke beziehen, können mit der Formel von Lorentz-Lorenz umgerechnet werden (siehe z.B. M. Born, E. Wolf, Principles of Optics, 6th ed., (Pergamon, London 1980), pp. 87-98).

10

1) Ersatz von Luft bei 248,4 nm durch ein Stickstoff-Helium-Gemisch:



20

Aus den Brechzahlen für trockene Luft mit 79,5 Volumenprozent Stickstoff (N) und 20,5 Volumenprozent Sauerstoff (O2) gemäß den Brechzahlen von Luft nach F. Kohlrausch, Praktische Physik, Band 1, Kap. 5.1.1.2.3, (B.G. Teubner, Stuttgart, 1968) von 1,0002763, für Stickstoff gemäß den Brechzahlen von Stickstoff nach U. Griesmann, J.H. Burnett, "Refractivity of nitrogen gas in the vacuum ultraviolet", OPTICS LETTERS, Vol. 24, No. 23 (Dec. 1999) von 1,0002797 und für Helium gemäß den Brechzahlen von Helium nach R. Abjean, A. Mehu, A. Johannin-Gilles, "Mesure interferometrique des indices de refraction de l'helium et du neon dans l'ultraviolet", C.R.Acad.Sc.Paris, t271 (19 oct 1970) - Serie B - 835 von 1,0000314 berechnet sich das Mischungsverhältnis zu 1,36 % Helium mit 98,64 % Stickstoff.

2) Ersatz von synthetischer Luft bei 248,4 nm durch ein Stickstoff-Helium-Gemisch:

30

a) synthetische Luft mit 80 % Stickstoff und 20 % Sauerstoff: Aus den Brechzahlen für Stickstoff gemäß Feststellung wie zu 1) Brechzahlen zu Stickstoff von 1,0002797 und für Sauerstoff gemäß den Brechzahlen von Sauerstoff nach R. Ladenburg, G. Wolfsohn, Z.Phys. 79 [1932] 42/61, 53, von 1,0002642 erhält man die Brechzahl der synthetischen Luft (80 % N_2 , 20 % O_2) zu 1,0002766. Mit der Brechzahl für Helium gemäß Feststellung wie zu 1) von 1,0000314 berechnet sich das Mischungsverhältnis des

Ersatz-Gemisches zu 1,24 % Helium mit 98,76 % Stickstoff.

10

20

25

b) synthetische Luft mit 78 % Stickstoff und 22 % Sauerstoff: Aus den Brechzahlen für Stickstoff gemäß Feststellung wie zu 2a) von 1,0002797 und für Sauerstoff gemäß Feststellung wie zu 2a) von 1,0002642 erhält man die Brechzahl der synthetischen Luft (78 % N_2 , 22% O_2) zu 1,0002763. Mit der Brechzahl für Helium gemäß Feststellung wie zu 1) von 1,0000314 berechnet sich das Mischungsverhältnis des Ersatz-Gemisches zu 1,37 % Helium mit 98,63 % Stickstoff.

Bei anderen Wellenlängen ist gegebenenfalls ein anderes Stickstoff-Edelgas-Gemisch vorzusehen. Dies gilt z.B. für einen Ersatz von (synthetischer) Luft bei 193 nm. In diesem Falle kann man anstelle von Helium z.B. Krypton und Xenon als alternative Edelgase verwenden.

Projektionsobjektive für die Halbleiter-Lithographie verändern häufig während des Betriebes oder des Transportes ihre Abbildungseigenschaften. Diese müssen deshalb von Zeit zu Zeit über mechanische Manipulatoren korrigiert werden. Wenn man nun eine gezielte inhomogene Spülung eines oder mehrerer gegen das restliche Objektiv weitgehend abgedichtete Lufträume mit Gasen von unterschiedlichen Brechungsindizes vornimmt, so können gegebenenfalls mechanische Manipulatoren eingespart werden. Hierzu können entsprechend am Umfang verteilt angeordnete Düsen unterschiedlich Gase über die Düsen in den Luftraum des Objektives einsprühen. Auf diese Weise ergeben sich über den Umfang verteilt - je nach eingebrachten Gasen - unterschiedliche Brechungsindizes der Gase entsprechend unterschiedliche lokale Brechungsbereiche in dem Luft- bzw. Gasraum. Diese lokal unterschiedlichen Brechungsbereiche sind dabei abhängig von der Lage und der Einströmrichtung der Gase. So werden sich z.B. in der Nähe des Düsenbereiches eines spezifischen Gases Bereiche ergeben, die dem Brechungsindex des einströmenden Gases entsprechen, während in anderen Bereichen entsprechende Mischungen mit einem weiteren Gas oder auch mit mehreren anderen Gasen vorliegen, woraus entsprechend ein anderer Brechungsindex in diesem

Bereich resultiert. Auf diese Weise lassen sich Bildfehler während des Betriebes des Projektionsobjektives manipulieren mit daraus sich ergebenden Effekten, die der Wirkung von z- und x-/y-Manipulatoren oder einer aktiven Linse entsprechen.

Voraussetzung ist hierfür selbstverständlich, daß sich während des Betriebes ein stationärer oder wenigstens quasistationärer Betrieb einstellt bzw. daß sich entsprechend reproduzierbare Bereiche in dem Gasraum mit konstanter Gaszusammensetzung ergeben, damit sich reproduzierbare Verhältnisse bezüglich der Korrektur von Abbildungseigenschaften ergeben. Dies bedeutet, es müssen sich gezielte, stabile Mischungsgradienten der Gase in

Konstruktiv bedeutet dies, daß die in der Figur 1 dargestellten Einlaßöffnungen 5a und Auslaßöffnung 5b entsprechend über ihren Umfang des Objektives 1 verteilt anzuordnen sind und über die Einlaßöffnungen lokal unterschiedliche Gase eingeleitet werden.

dem abgeschlossenen Gasraum darstellen lassen.

In der Figur 2 ist schematisch eine Projektionsbelichtungsanlage dargestellt mit einem Projektionsobjektiv 1 gemäß Darstellung in der Figur 1. Da die Projektionsbelichtungsanlage gemäß Ausführungsbeispiel grundsätzlich bekannt ist, siehe z.B. DE 100 02 26 A1, wird nachfolgend nur kurz auf deren Aufbau eingegangen. Sie besteht aus einer Lichtquelle 6, einem Beleuchtungssystem 7, einer Strukturmaske 8, auch Reticle genannt, dem Projektionsobjektiv 1, das als Reduktionsobjektiv ausgebildet ist, und einem zu belichtenden Objekt, nämlich einem Wafer 9. Als Lichtquelle 6 kann z.B. ein Excimer-Laser eingesetzt werden. In dem Beleuchtungssystem 7 sind optische Komponenten zur Strahlformung, zur Strahlhomogenisierung und zur korrekten Ausleuchtung der Strukturmaske 8 und des Projektionsobjektives 1 vorgesehen. Das zu belichtende Objekt kann ein mit Photolack beschichteter Silicium-Wafer 9 sein.

20

Patentansprüche: '

- 1. System zum Spülen wenigstens eines abgeschlossenen Innenraumes (4) eines Objektives (1), wobei die Spülung durch
 ein Mischen von wenigstens zwei inerten Gasen derart erfolgt, daß der daraus resultierende Brechungsindex wenigstens annähernd dem Brechungsindex von Luft entspricht.
- 2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Luft oder synthetische Luft mit 78-80 Vol.-% Stickstoff (N_2) und 20-22 Vol.-% Sauerstoff (O_2) vorgesehen ist.



20

5

- 3. System nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Objektiv (1) als Projektionsobjektiv für die Halbleiter-Lithographie vorgesehen ist.
- 4. System nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß bei Verwendung von zwei inerten Spülgasen der Brechungsindex von einem Spülgas über dem von Luft und der Brechungsindex des zweiten Spülgases unter dem von Luft liegt.
- System nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß als erstes Spülgas Stickstoff und als zweites Spülgas ein Edelgas verwendet wird.



- 6. System nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß als Edelgas Helium verwendet wird.
- 30 7. System nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß als Edelgas Krypton verwendet wird.
 - 8. System nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß als Edelgas Xenon verwendet wird.

35

9. System nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß Stickstoff in einem Volumenanteil von 95 bis 99,5 % und Helium in einem Volumenanteil von 0,5 bis 5 % verwendet wird. 10. System nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß Helium in einem Volumenanteil von 1,1 bis 1,3, vorzugsweise 1,2 % verwendet wird.

5

10

- 11. Verfahren zum Spülen wenigstens eines abgeschlossenen Innenraumes (4) eines Objektives (1), wobei eine Mischung aus wenigstens zwei inerten Gasen über wenigstens eine Einlaßbohrung (5a) in den wenigstens einen Innenraum (4) eingebracht wird, deren aus der Mischung resultierende Brechungsindex wenigstens annähernd dem Brechungsindex von Luft entspricht, wonach die Mischung über wenigstens eine Auslaßbohrung (5b) wieder aus dem Innenraum (4) entfernt wird.
- 12. Verfahren zum Spülen wenigstens eines abgeschlossenen Innenraumes (4) eines Objektives (1), wobei wenigstens zwei inerte Gase über wenigstens eine Einlaßbohrung (5a) derart in den Innenraum (4) eingeleitet werden, daß der aus der Mischung der Gase resultierende Brechungsindex wenigstens annähernd dem Brechungsindex von Luft entspricht, wonach die Mischung über wenigstens eine Auslaßbohrung (5b) entfernt wird.
- 25 13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Objektiv (1) als Projektionsobjektiv für die Halb-leiter-Lithographie vorgesehen ist.
- 14. Projektionsbelichtungsanlage für die Halbleiter-Lithographie, wobei für die Spülung wenigstens eines abgeschlossenen Innenraums (4) des Projektionsobjektives (1) der Projektionsbelichtungsanlage eine Mischung von wenigstens zwei
 inerten Gasen derart vorgesehen ist, daß der daraus resultierende Brechungsindex wenigstens annähernd dem Brechungsindex von Luft entspricht.
 - 15. Verfahren zur Herstellung von mikrostrukturierten Bauteilen mit einem Projektionsobjektiv (1), wobei wenigstens ein ab-

geschlossener Innenraum (4) des Projektionsobjektives (1) mit einer Mischung von wenigstens zwei inerten Gasen derart gespült wird, daß der daraus resultierende Brechungsindex wenigstens annähernd dem Brechungsindex von Luft entspricht.



Zusammenfassung: •

System zum Spülen wenigstens eines Innenraumes eines Objektives

5 (Figur)

Bei einem System zum Spülen wenigstens eines Innenraumes 4 eines Objektives 1, insbesondere eines Objektives in der Halbleiter-Lithographie, erfolgt die Spülung durch ein Mischen von wenigstens zwei inerten Gasen derart, daß der daraus resultierende Brechungsindex wenigstens annähernd dem Brechungsindex von Luft entspricht.



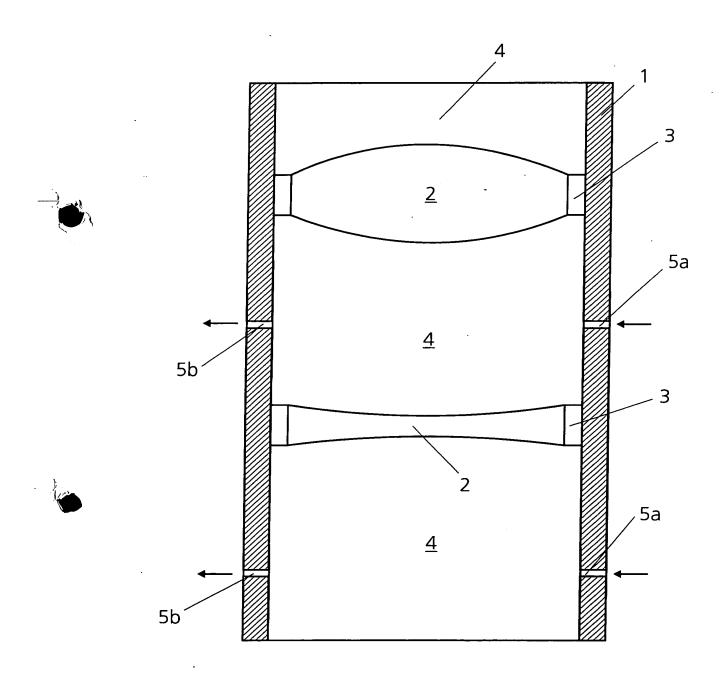


Fig. 1

